ハ～ワ　［略］

カ　相補型金属酸化膜半導体集積回路であって、零下二六八・六五度以下の温度で作動するように設計したもの（ロに該当するものを除く。）

二　マイクロ波用機器又はミリ波用機器の部分品であって、次のいずれかに該当するもの

イ～ヲ　［略］

ワ　周波数シンセサイザーを用いた電子組立品のうち、次のいずれかに該当するもの

（一）～（七）　［略］

カ　［略］

三～九　［略］

十　アナログデジタル変換器のうち、アナログデジタル変換を行う機能を有するモジュール、電子組立品又は装置（アナログデジタル変換カード、波形デジタイザー、データ収集カード、信号収集ボード及びトランジェントレコーダーを含む。）であって、次のイ及びロに該当するもの（デジタル方式の記録装置、サンプリングオシロスコープ、スペクトラムアナライザー、信号発生器、ネットワークアナライザー及びマイクロ波用試験受信機を除く。）

イ・ロ　［略］

十一～十六の二　［略］

十七　半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置（ホ及びレにおいて「半導体製造装置」という。）若しくは試験装置若しくは集積回路の製造用のマスク若しくはレチクルであって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品若しくは附属品（次号に該当するものを除く。）

イ～ル　［略］

ヲ　ウエハーの処理のためのステップアンドリピート方式又はステップアンドスキャン方式の露光装置であって、光源の波長が一九三ナノメートル以上のもののうち、次の（一）及び（二）に該当するもの（へ（一）２に該当するものを除く。）

（一）　ナノメートルで表した光源の波長に〇・二五を乗じて得た数値を開口数の値で除して得た数値が四五以下のもの

（二）　同一装置による重ね合わせ精度の最大値が二・四ナノメートル以下のもの

ワ～タ　［略］

レ　半導体製造装置のうち、成膜装置であって、次のいずれかに該当するもの

（一）　電気メッキ又は無電解メッキによりコバルトを成膜するように設計したもの

（二）　化学的気相成長法によりコバルトを充填するように設計したもの又は選択性のボトムアップ成膜を用いる化学的気相成長法によりタングステンを充填するように設計したもの

（三）～（五）　［略］

（六）　仕事関数金属（トランジスタの閾値電圧を制御するための材料をいう。以下同じ。）を原子層堆積法により成膜するように設計した装置であって、次の全てに該当するもの

１　二以上の金属の供給源を有するもののうち、アルミニウムの前駆体用に設計した供給源を一以上有するもの

［削る］

ハ～ワ　［略］

［新設］

二　マイクロ波用機器又はミリ波用機器の部分品であって、次のいずれかに該当するもの

イ～ヲ　［略］

ワ　周波数シンセサイザーを用いた組立品のうち、次のいずれかに該当するもの

（一）～（七）　［略］

カ　［略］

三～九　［略］

十　アナログデジタル変換器のうち、アナログデジタル変換を行う機能を有するモジュール、組立品又は装置（アナログデジタル変換カード、波形デジタイザー、データ収集カード、信号収集ボード及びトランジェントレコーダーを含む。）であって、次のイ及びロに該当するもの（デジタル方式の記録装置、サンプリングオシロスコープ、スペクトラムアナライザー、信号発生器、ネットワークアナライザー及びマイクロ波用試験受信機を除く。）

イ・ロ　［略］

十一～十六の二　［略］

十七　半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置（ホ及びレにおいて「半導体製造装置」という。）若しくは試験装置若しくは集積回路の製造用のマスク若しくはレチクルであって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品若しくは附属品（次号に該当するものを除く。）

イ～ル　［略］

ヲ　ウエハーの処理のためのステップアンドリピート方式又はステップアンドスキャン方式の露光装置であって、光源の波長が一九三ナノメートル以上のもののうち、次の（一）及び（二）に該当するもの（へ（一）２に該当するものを除く。）

（一）　ナノメートルで表した光源の波長に〇・二五を乗じて得た数値を開口数の値で除して得た数値が四五以下のもの

（二）　同一装置による重ね合わせ精度の最大値が二・四ナノメートル以下のもの

ワ～タ　［略］

レ　半導体製造装置のうち、成膜装置であって、次のいずれかに該当するもの

（一）　電気メッキ又は無電解メッキによりコバルトを成膜するように設計したもの

（二）　化学的気相成長法によりコバルトを充填するように設計したもの又は選択性のボトムアップ成膜を用いる化学的気相成長法によりタングステンを充填するように設計したもの

（三）～（五）　［略］

（六）　仕事関数金属（トランジスタの閾値電圧を制御するための材料をいう。以下同じ。）を原子層堆積法により成膜するように設計した装置であって、次の全てに該当するもの

１　二以上の金属の供給源を有するもののうち、アルミニウムの前駆体用に設計した供給源を一以上有するもの

［新設］

ワ～タ　［略］

レ　半導体製造装置のうち、成膜装置であって、次のいずれかに該当するもの

（一）　電気メッキによりコバルトを成膜するように設計したもの

（二）　コバルト又はタングステンをボトムアップ成膜によって充填する工程において充填する金属の空隙又は継ぎ目の最大寸法が三ナノメートル以下となるように設計した化学的気相成長装置

（三）～（五）　［略］

（六）　仕事関数金属（トランジスタの閾値電圧を制御するための材料をいう。以下同じ。）の原子層堆積装置であって、次の全てに該当するもの

１　次の全てに該当するもの

一　二以上の金属の供給源を有するもののうち、アルミニウムの前駆体用に設計した供給源を一以上有するもの